



ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 428.

09 июня 2012 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Москва

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС"

ДИПЛОМ

К № 04528

Решением
Государственной аттестационной комиссии

от 05 июня 2012 года

Малых

Антону Александровичу

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

инженер
по специальности

"Микроэлектроника и твердотельная электроника"



С.С.С.С.
С.С.С.С.



Фамилия, имя, отчество

Малых Антон Александрович

Дата рождения 19 июля 1990 года

Предыдущий документ об образовании

аттестат о среднем (полном) общем образовании,
выданный в 2007 году

Вступительные испытания прошел

Поступил(а) в 2007 году в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» (очная форма)

Завершил(а) обучение в

2012 году в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»* (очная форма)

Нормативный период обучения по очной форме 5 лет

Направление/специальность **Микроэлектроника и твердотельная электроника**

Специализация **Физика и технология интегральных микросхем и полупроводниковых приборов**

Курсовые работы:

Проектирование вентиля, отлично

Расчет технико-экономических показателей цеха по производству материалов электронной техники, хорошо

Вывод формулы для ОПЗ гетероперехода, отлично

Двухпозиционный микропроцессорный регулятор температуры, хорошо

Агрессия как социально-психологический феномен, отлично

Продолжение на обороте

Практика:

Технологическая, 2 недели, отлично

Технологическая, 4 недели, отлично

Преддипломная, 6 недель, отлично

Итоговые государственные экзамены:

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

на тему: «Исследование характеристик преобразователя типа магнитная индукция-частота на основе полевого датчика Холла», 16 недель, отлично

Данный диплом дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем образования и квалификацией.

Продолжение см. на обороте



РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ



г. Москва

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ДИПЛОМУ

№ К № 04528

428

(регистрационный номер)

09 июля 2012 года
(дата выдачи)

Решением
Государственной
аттестационной
комиссии

от 05 июня 2012 года

присуждена
квалификация
инженер
по специальности
«Микроэлектроника
и твердотельная
электроника»

Ректор

Декан

Секретарь



За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин		Общее количество часов	Итоговая оценка
1.	Философия	192	хорошо
2.	Иностранный язык	350	отлично
3.	Политология и правоведение	150	отлично
4.	Отечественная история	180	хорошо
5.	Физическая культура	408	зачет
6.	Математический анализ	582	отлично
7.	Аналитическая геометрия	118	хорошо
8.	Информатика	300	отлично
9.	Общая физика	523	хорошо
10.	Квантовая механика	142	зачет
11.	Статистическая физика	86	удовлетворительно
12.	Химия	186	удовлетворительно
13.	Экология	70	отлично
14.	Методы математической физики	162	удовлетворительно
15.	Инженерная и компьютерная графика	124	зачет
16.	Материаловедение	196	хорошо
17.	Электротехника	145	удовлетворительно
18.	Электроника	118	хорошо
19.	Метрология, стандартизация и сертификация	118	отлично
20.	Безопасность жизнедеятельности	90	отлично
21.	Организация и планирование производства	118	отлично
22.	Вакуумная и плазменная электроника	114	отлично
23.	Твердотельная электроника	108	отлично
24.	Микроэлектроника	108	отлично
25.	Квантовая и оптическая электроника	108	отлично
26.	Основы экономической теории	150	отлично
27.	Экономика производства	120	хорошо
28.	Кристаллофизика	204	хорошо
29.	Физика диэлектриков	86	отлично
30.	Основы математического моделирования	86	зачет
31.	Моделирование технологических процессов	86	зачет
32.	Русский язык и культура речи	40	хорошо
33.	История науки и образования	130	зачет
34.	Психология и педагогика	32	зачет
35.	Оборудование полупроводникового производства	64	хорошо
36.	Физика полупроводниковых приборов	76	отлично
37.	Полевые полупроводниковые приборы	85	отлично
38.	Электронная структура твердых тел	135	хорошо
39.	Электронные и оптические свойства твердых тел	135	отлично
40.	Физическая химия	228	удовлетворительно
41.	Технология материалов электронной техники	115	хорошо
42.	Процессы микро- и нанотехнологии	115	отлично
43.	Методы исследования материалов и структур электроники	124	хорошо
44.	Микросхемотехника	192	отлично
45.	Курсовая научно-исследовательская работа	100	отлично
46.	Основы лучевой технологии микроэлектроники	122	отлично
47.	Физика импульсного отжига микроэлектронных структур	91	зачет
48.	СВЧ-приборы и интегральные микросхемы	118	зачет
49.	Полупроводниковые оптоэлектронные приборы	91	зачет
50.	Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем	91	отлично
51.	Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов и СБИС	150	отлично
Курсовые работы (продолжение)			
Разработка мощного СВЧ-транзистора для оконечных каскадов передающих устройств в аппаратах связи			отлично
Расчет полного числа смещенных атомов при облучении кремния быстрыми протонами с энергией 6 МэВ			отлично
Расчет параметров п-р-п гетеротранзистора с эмиттером из Al _x Ga _{1-x} As и базой и коллектором из GaAs			отлично
Расчет ионной имплантации и термического отжига для создания р-п-перехода фиксированной глубины			отлично
Ионные ускорители			хорошо
ВСЕГО		7812	

в том числе аудиторных (4352)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» с 01.09.2009 г. на основании приказа Рособразования от 25 июня 2009 г. № 710.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» создано путем изменения типа Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» на основании приказа Минобрнауки России от 31 мая 2011 г. № 1977.

Конец документа

